自由电子受激辐射

(中国科学院电子学研究所)

昭

尹元

一、引 冨

高功率短波长和波长连续可调高功率激 光器一直是激光研究的两个主要方向,自由 电子受激辐射正是这样一种新途径。原则上, 它可以实现从毫米波到 X 波段 直至 γ 激光 的波长可连续调谐的大功率激光器,因此,已 引起人们的普遍重视。

利用自由电子受激辐射制成的激光器叫 自由电子激光器。其物理基础就是光子与电 子的相互作用。但从相互作用过程中要满足 能量守恒与动量守恒可知:一个自由电子不 能吸收或发射一个光子,而只能散射光子,这 是一种自发辐射,并不能产生激光束。要使自 由电子与光子相互作用产生激光,必须在某 种条件下实现受激辐射。所谓自由电子其实 在与光子相互作用时并非严格自由的,但它 和普通的基于束缚在原子、分子或离子上的 电子的振-转能级或电子能级之间的 跃迁的 激光器相比,把这类电子束产生受激辐射的 器件叫做自由电子激光器是合适的。

自由电子受激辐射的设想是在 50 年代 初期⁽¹⁾提出的,直到 1974 年才首次在毫米波 段实现了受激辐射⁽²⁾,1977 年又在红外波段 实现了受激辐射⁽³⁾,从而大大推动了对自由 电子受激辐射的研究。当然这是一个新颖和 困难的课题,无论在理论上和实验上都很不 成熟,需要进一步探讨。

本文简要地讨论自由电子产生受激辐射

的几种主要原理,介绍相应的实验器件,并指 出自由电子受激辐射的发展方向与应用前 景。

二、相对论镜子的作用[5]

设有一面完全理想的镜子以相对论速度 υ沿实验室坐标系 s 的 z 轴方向运动,与入射 电磁波对头相碰。设入射电磁波和反射电磁 波的频率与波矢分别是ω_i、k_i和ω_r、k_r,按 洛仑兹变换公式在电子静止坐标系 s'中(相 应的量都加上一撇表示)有(图1)



$$\omega_i = r(\omega_i + vk_i) = r(1+\beta)\omega_i \qquad (1)$$

$$\omega_r' = r(\omega_r - vk_r) = r(1 - \beta)\omega_r \qquad (2)$$

显然有 $\omega_i = \omega_r$,所以得

$$\omega_{\mathbf{r}} = \left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)\omega_{\mathbf{i}} \approx 4r^2\omega_{\mathbf{i}} \tag{3}$$

其中

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad r = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \tag{4}$$

收稿日期: 1978年10月24日。

可见对头相碰实现了频率的上变换。再根据 电磁场的变换关系可以求得入射与反射电磁 波的功率在二个坐标系之间的关系:

$$P_{r} = \left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right) P'_{r}, \quad P_{i} = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right) P'_{i} \quad (5)$$

即得

$$\frac{P_r}{P_i} = \left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)^2 \frac{P_r'}{P_i'} \tag{6}$$

对于完全理想的镜子 $P'_r = P'_i$, 则

$$P_r = \left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)^2 P_i \approx (2r)^4 P_i \qquad (7)$$

可见电磁波的功率经对头碰后也得到了放 大。

对于入射电磁波方向与镜子运动方向相 同即所谓平行碰情形,只要将上述公式中的 β用-β代之即可,于是有

$$\omega_r = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)\omega_r = \frac{1}{4r^2}\,\omega_i \tag{8}$$

$$P_{r} = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)^{2} P_{i} = \frac{1}{(2r)^{4}} P_{i} \qquad (9)$$

可见平行碰实现了频率的下变换但反射波功 率大大减少,因而实用化是困难的。

如果镜子不是理想的,在电子静止坐标 中按电磁波从不连续媒质反射的 Fresnel 公 式可求得反射系数 R 为

$$R = \frac{P_r'}{P_i'} = \left(\frac{1-n}{1+n}\right)^2 \tag{10}$$

其中n是镜子折射率。于是代替(7)式有

$$P_{\mathbf{r}} = \left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)^2 \left(\frac{1-n}{1+n}\right)^2 P_{\mathbf{i}} \qquad (11)$$

由此可见问题归结为如何在实验上实现 这个相对论镜子的问题。

一个沿轴向磁场运动的相对论强流电子 束可看成是这样一面镜子,在电子静止坐标 中其折射率为

$$n = 1 - \frac{\omega_{re}^2}{\omega(\omega - \omega_{Be})} \tag{12}$$

其中 ω_{pe} 是电子等离子体振荡频率, ω_{Be} 是电子在轴向磁场B中的回旋频率。

$$\omega_{pe} = \frac{4\pi n_e^2 e^2}{m_e} \tag{13}$$

$$\omega_{Be} = \frac{B_e}{m_e C} \tag{14}$$

其中 ne, me 是电子密度和质量, e 是电子电荷。

如 $\omega = \omega_{Be}$ 即在电子静止坐标中波的频率 ω 等于电子回旋频率,则 $n \gg 1$, $R \simeq 1$,即是理想的镜子。这个条件可写成

$$r(1+\beta)\omega_i = \frac{B_e}{m_e C} \tag{15}$$

 $\omega_i = 1.77 \times 10^7 B \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}, B \sim \tilde{a}$ (16)

或

一个实验证明是美国海军研究实验室在 1976年公布的结果(图2)^[5]。用一电压为 900千电子伏的无膜二极管,电压上升时间 13 毫微秒, 电流上升时间 9 毫微秒, 在脉宽 ~50 毫微秒内接近平顶,总电流~2千安,电 子束成环形, 外径~φ11 毫米, 壁厚 2 毫米。 磁控管微波源产生 3.2 厘米、脉宽~0.5 微 秒、功率170千瓦的入射电磁波,测得反射电 磁波长~8毫米,相应的β~0.6,电子束能 量~150千电子伏。 电流 330 安, 脉宽数毫 微秒,非常小干电子束脉宽,这表明确是表面 作用而不是体积作用,如是体积作用,频率变 换应对应 900 千电子伏, 输出电磁波脉宽应 与电子束脉宽大致相同。又输出功率300千 瓦, 对应 R~6%, 这是因为先发射的电子被 后发射的电子所驱赶而形成一个电子束非理 想的前表面,它存在能量梯度,因此相当于有 大的吸收。直流磁场有一最佳值约在5千高



斯左右。类似的实验还可见[6],但在那里相 对论电子束既用来激起入射的电磁波又用来 作为相对论镜子,显然不利于使实验条件最 佳化。

三、受激康普顿辐射和 康普顿激光器

当光子与高能电子相碰时(图3),可按能量守恒和动量守恒列出下列三个方程:



$$m_1v_1 + \frac{h\nu_1}{c}\cos\theta_1 = m_2v_2\cos\phi$$

$$+\frac{h\nu_2}{c}\cos\theta_2\tag{19}$$

$$\frac{h\nu_1}{c}\sin\theta_1 = m_2 v_2 \sin\phi - \frac{h\nu_2}{c}\sin\theta_2$$
(20)

经过简单运算可得

$$\nu_{2} = \nu_{1} \frac{m_{1}c^{2} - cm_{1}v_{1}\cos\theta_{1}}{m_{1}c^{2} + h\nu_{1}(1 - \cos\theta) - cmv_{1}\cos\theta_{2}}$$
(21)

当电子是静止时, m1v1=0, 有

$$\nu_2 = \nu_1 \frac{1}{1 + \frac{h\nu_1}{m_0 c^2} (1 - \cos \theta)}$$
(22)

这就是光子被静止电子散射后频率变低的康 普顿—吴有训效应。

当入射光子与电子方向相反(对头碰)而

散射光子,在入射电子方向(反向散射)时散 射光子能量最大。从(21)式令 $\theta_1 = \pi, \theta_2 = 0$, 得

$$\nu_{2\max} = \nu_1 \frac{1+\beta}{1-\beta} \approx 4r^2 \nu_1$$
 (23)

这就是频率上变换或称逆康普顿—吴有训效 应。

当电子方向与入射光子方向相同(平行 碰),而散射光子与入射电子方向相反(反向 散射)时散射光子能量最小。从(21)式令 $\theta_1=0, \theta_2=\pi, 得$

$$\nu_{2\min} = \nu_1 \frac{1-\beta}{1+\beta} \approx \frac{\nu_1}{4r^2}$$
 (24)

这就是频率下变换。

然而这些都是自发康普顿散射,虽然频 率可移但并非激光。

1933 年 Kapitza 与 Dirae^[7] 从理论上预 言了受激康普顿散射的存在。如图 4 所示,设 O 是光源经透镜 D 变成平行光 再 经 全 反 射 镜 C 反射,在 D 与 C 之间形成驻 波。 A 是 电子源,B 是加速栏片。如无受激康普顿效 应存在,则电子束径直到达 E 处,如有受激 康普顿效应存在,则有部分电子到达 E' 处。 这是因为驻波相当于同一频率的二束行 波, 每束都引起自发的康普顿散射,一个光束的 光子被电子吸收然后向任意方向再发射,而 电子受到反冲偏离原来的方向。由于这二束 光引起的偏离相互抵消,所以电子方向不变。 但若电子从一束光吸收光子,因另一束光的 存在而受激地再发射光子,则电子经受的反



冲是相加的,就有一定的几率出现在 E' 处, 这就叫做受激康普顿效应或以其创始人命名 叫做 K-D 效应。这个过程当然要服从能量 与动量守恒,又因受激辐射的光子与激起这 个过程的光子应有相同的频率与方向,所以 再发射光子与被吸收光子有同一频率但方向 相反,所以在这过程中电子获得的动量为 $2\frac{hv}{c}$,它与驻波面垂直,能量交换等于零,这 样电子从驻波面反射的反射角等于入射角。 设电子的德布洛意波长为 λ_e,驻波频率为 v,波长为 λ,则有

$$2 \frac{h\nu}{c} = 2 \frac{h}{\lambda_e} \cos \theta$$
$$\lambda_e = \lambda \cos \theta$$

或

这正是晶格常数为 $\frac{\lambda}{2}$ 的布拉格定律。理论 计算表明这种受激康普顿散射的截面是非常 小的,只有激光出现后,有了强光源才得到了 实验证明¹⁸¹。这里还要说明的是 *K*-D 效应 仅是电子被光驻波的布拉格散射,仅有动量 交换而无能量交换,而受激康普顿效应是一 个更广泛的概念,它包括 *K*-D 效应,也包括 更重要的有能量交换的情形。

利用受激康普顿效应制成的激光器就叫做康普顿激光器。一个简单的设想可用图 5 表示^[0]。

电子束与频率为 v_p 的泵浦激光束相碰 产生受激辐射,其频率为 v_s,在谐振腔中来回





振荡引起受激康普顿辐射,一部分输出腔外。 在微波波段可用微波谐振腔输入泵浦波,一 个实验设想如图 6^[10]:

有不少理论工作者计算康普顿激光器的 增益^[9~12],对于足够长的相互作用区,上变 换的增益是^[10,11]:

$$\alpha = K r_0^2 \frac{E}{\Delta E} \frac{h \nu_2}{\Delta E} \lambda_1 \lambda_2^2 \rho_e \rho_f$$

其中 r_0 是电子经典半径, E 是电子束能量, ΔE 是电子束能量分散, ρ_e 是电子束中的电 子密度, ρ_f 是光子束中光子密度, K 是数量 级为1的系数, λ_1 是入射光波长, λ_2 是散射 光波长, ν_2 是散射光频率。按这个公式计算, 当 E=2 兆电子伏, $\frac{E}{\Delta E}=10^5$, $j_e=10^5$ 安/ 厘米², 相应 $\rho_e=2\times10^{13}$ 厘 \times^{-3} , $\lambda_1=1.06$ 微 χ , $\rho_f=1.8\times10^{22}$ 厘 \times^{-3} , 得到 $\lambda_2=166$ 埃, $\alpha=2.2$ 厘 \times^{-1} 。

后来有人指出如受激康普顿过程在轴向 磁场中进行,并使电子在磁场中的回旋频率

表1 脉冲工作典型参量

and the second of the second of the second se			
入射波长λ1(厘米)	5 5		
出射波长λ2(微米)	~200	~2000	
入射微波功率(脉冲)	310 m 112	1.加加1%和	
(兆瓦/厘米2)	12	1.2	
相互作用区长(厘米)	100	100	
电子束电流(安培)	400	100	
电子束截面(厘米2)	1	1	
总电子束能量 E(兆电子伏)	4(动能3.5)	1.2(动能0.7)	
电子束持续时间	300 毫微秒	1 微秒	
谐振磁场 B(高斯)	~35500	11000	
对磁场均匀性要求	≪1%	≪1%	
增益(厘米-1)	~5	~3	
在λ2波长输出之能量(焦耳)	5	1	
电子束能量分辨率 _ <u>E</u>	~35	~35	

等于电子静止坐标中的入射光子频率,则增 益可大大增加,这称为磁谐振受激康普顿散 射^[12]。虽然理论计算的结果(见表 1)是乐观 的,但是迄今还未看到成功的实验结果。

四、受激韧致辐射和 磁韧致激光器

美国加里福尼亚大学以 Madey 为首的 一个小组研制成功的自由电子激光器就是一 种磁韧致激光器。设高能电子沿 z 轴进入横 向周期静磁场中,因磁场作用,轨迹发生偏 转,产生韧致辐射(图7)。为了计算增益采 用了所谓虚光子的办法。先在电子静止坐标 中进行计算,这时周期静磁场相当于入射到 静止电子上的虚光子(真实光子的静止质量 为零,而虚光子静止质量不为零),问题就归 结为受激康普顿散射,可利用现成的结果,然 后再变回到实验室坐标,从而简化了计算。其 主要结果是^[13-14].



最大理论增益 $G = \frac{20 \lg e}{\pi} \left(\frac{1}{e\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{r_0^2}{mc^2}\right)$ × $\lambda^{3/2} \lambda_q^{3/2} B^2 \rho_e \left(\frac{\Delta \nu}{\nu}\right)^{-2} F_f 分 贝·米^{-1}$ (25)

辐射波长

$$\lambda = \frac{\lambda_g}{2r^2} \left[1 + \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \frac{\lambda_g^2 r_0}{mc^2} B^2 \right] \\ \times \left(1 + \frac{h\nu}{rmc^2} \right)$$
(26)

相对频宽

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \simeq \frac{\lambda_q}{2L} = \frac{1}{2n} \tag{27}$$

其中 λ_a 是静磁场的周期, F_f 是电子束和辐射 场半径之比,如电子束半径超过辐射场半径 则 $F_f=1$, ν 是输出激光辐射的频率, $\Delta \nu$ 是自 发辐射线宽, n是磁场周期数, mc^2 是电子 静止能量, L是相互作用区长度。

从上述公式可见:

(1) 调谐性。 因为 $r = \frac{E}{E_0}$, *E* 是电子能 量, $E_0 = mc^2$ 是电子静止能量,所以 $\lambda \propto \frac{1}{E^2}$, 当改变电子束电压时就可改变激光波长,这 可叫电压调谐。另一方面磁场强度对激光波 长也有影响。

(2) 增益随波长 3/2 次方减少, 所以短波 长工作要求大大增加电子束电流密度和磁场 强度。

(3)减少相对频宽可提高增益。这要求 相互作用区长度 L 大而静磁场周期 λ_a 小。

(4) 虚光子方法适用条件是 r≫1, 所以 要用相对论电子束。

总之,为了产生短波长,要求用强流相对 论电子束和超导磁场,以产生足够高的轴向 磁场和足够小的磁场周期。静磁场可看成是 零频电磁波,所以这是一个上变换器件。

按照这个原理, Madey 小组在 1976 年第 一次实现了激光放大^[14],在 1977 年第一次 实现了激光振荡^[3],从而大大推动了自由电 子激光器的研究。



作为放大器,其实验参数为并排间绕的 双螺线管,长5.2米,周期3.2厘米,轴上磁 场2.4千高斯,电子束通道直径10.2毫米, 电子束能量24兆电子伏,脉冲峰值电流70 毫安,对10.6微米的 CO_2 激光获得每行程 7%的增益,而且在功率密度100~1.4×10⁵ 瓦/厘米²范围内增益与功率密度无关,因此 估计可做到10⁵~10⁶瓦的功率输出(图 8(a))。

作为振荡器,其磁场情况与放大器相同, 但电子束能量为43.5兆电子伏,平均电流 130微安,峰值电流2.6安,输出镜透射率 1.5%,光腔长12.7米,输出激光波长为 3.417微米,平均功率0.36瓦,峰值功率 7×10³瓦,电子束能散度 <3×10⁻³(图 8(b))。他们进一步希望用1安、240兆电子 伏的电子束储存环产生100千瓦的可调谐激 光器,估计效率可达50%以上。

我们利用(26)式进行计算结果如表2所 示,可见与实验结果符合得相当好。因此用 18~20兆电子伏就可望在17~15微米范围 内实现连续调谐。现因波长增大了4倍,在 其他实验参数不变下增益增大了8倍,因此 产生16微米的激光应无原则问题。

₽(伏)	24×10^{6}	$43.5 \\ imes 10^6$	$\begin{array}{c} 18.5 \\ \times 10^6 \end{array}$	$19.3 \\ imes 10^6$	$\begin{vmatrix} 19.5 \\ \times 10^6 \end{vmatrix}$
7.	48.16	86.48	37.35	38.87	39.32
$\frac{\lambda_q}{2r^2}$ (微米)	6.8	2.1	11.4	1.06	10.3
λ(微米)	10.3	3.2	17.2	16	15.6

表2	电子束能量与激光波长的关系

为了提高效率,希望电子束能反复使用, 这样就要用储存环。与横向周期磁场作用过 的电子进入储存环,加速以恢复其原来的能 量再进入横向周期磁场。理论研究表明,虽 然经横向周期磁场作用电子运动状态发生了 改变,但与储存环结合是完全可能的^[15]。

四、受激喇曼散射及高功率 毫米波的产生

当入射光波与电子束相互作用时,一方 面激起电子束的等离子体振荡和密度疏密效 应,一方面又从这等离子体产生散射,散射波 与入射波进一步相互作用,使散射波大大增 强,这个过程就叫做受激喇曼散射。它与受 激康普顿散射的区别决定于电子束的德拜长 度与电磁波的波长之间的关系。电子束的德 拜长度 d 为

$$d = \sqrt{\frac{kT}{4\pi e^2 n_e}}$$

其中 T 是由电子无规运动决定的电子 温度, k 是波尔兹曼常数, e 是电子电荷, n_e 是电子 密度。若电磁波波长 $\lambda > d$,则电子束作为整 体与电磁波相互作用就是受激喇 曼散射,若 $\lambda < d$,则电磁波与单个电子相互作用就是受 激康普顿散射。显然当电子束能量高、密度低 时对应受激康普顿散射,当电子束能量低、密 度高时对应受激喇曼散射。

1974 年第一次用受激喇曼散射产生了 高功率的毫米波辐射^[2],以后进行不断的改 进,最近的典型结果如图 9 所示^[16]。圆环空 心电子束外径 3.6 厘米,壁厚 2 毫米,漂移管 内径 4.7 厘米,螺线管外径 15 厘米,薄铜板 直径 30 厘米。磁场起波结构是交替放置的 铝环与铁环。当电子束通过起波结构后大部 分轴向动能变成横向动能,在 L₂ 区域中这些 横向动能又大部分变为微波辐射(波长约 2 厘米,功率几百兆瓦),这部分辐射从黄铜板 反射,在 L₁ 区域与电子束相互作用产生受激



. 6 .

喇曼散射,转变成亚毫米波辐射(波长 0.4 毫 米,功率 1 兆瓦)。值得注意的是在受激喇曼 散射中,若电子在轴向磁场中的回旋频率等 于入射电磁波在电子静止坐标中的频率,则 输出功率可大为增加,这叫磁谐振受激喇曼 散射。这里电子束起着产生泵浦波与实现受 激散射的双重作用,不利于工作条件最佳化。 类似的实验还可见[17]。美国海军研究实验 室最近提出新方案将这双重作用分开,如图 10 所示^[18],预期能产生 100 千兆瓦、1 毫米 的辐射。



五、其他的自由电子 受激辐射形式

1. 受激韧致辐射与韧致激光器

当高能电子经过原子核周围受到原子核 库伦场的作用时,电子轨迹发生弯曲,产生辐 射,这就是库伦散射造成的韧致辐射。如同 时有一激光束存在,就可能引起受激韧致辐 射。Marcuse^[19] 计算了这种受激韧致辐射的 几率。计算结果表明在电子速度为非相对论 情况下,当电子束的轴与辐射光波的电矢量 平行时受激辐射几率最大,但以此为轴的角 度 108°的锥体内的电子对受激辐射都有贡 献,如图 11 所示。Winterberg^[20]在 Marcuse 工作的基础上计算了有强激光束存在时电子 束与等离子体相互作用产生的受激 韧致辐 射,可是没有看到相应的实验结果。



受激切伦柯夫辐射和切伦柯夫激光
 器

当电子在媒质中的速度超过光在该媒质 中的速度时,电子会产生辐射,这种辐射就叫 切伦柯夫辐射。用切伦柯夫效应产生毫米波 与亚毫米波辐射早就有人提出来了[21]。但为 了有效起见要求电子是群聚的,因而每个电 子产生的辐射相干地迭加; 电子经过媒质时 绝大部分能量都用于媒质电离,为此希望电 子穿过媒质中直径为波长数量级的空心通道 而不与媒质相触;希望辐射在谐振腔中进行, 由于腔的选模作用而得到线状谱。这些要求 不易实现,一直未成功。近来由于相对论强流 电子束的发展和自由电子受激辐射的推动, 这个问题又重新提了出来^[25]。Walsh^[22]等 人用 10 千安 0.5 兆伏的电子束经过 空心圆 柱介质负载波导得到中心频率为60千赫(5 毫米)的1兆瓦相干辐射。介质为丙烯树脂, 介电常数为2.5, 外径6.8 厘米, 内径4.4 厘 米。实验设备如图 12 所示。



最近, Gover 和 Yaviv^[23] 提出一种新的 结构如图 13 所示。高能电子束紧贴金属衍 射栅表面通过,电子在金属中感生出的象电 荷沿栅的锯齿面上下振动地前进,从而产生 电磁辐射。当谐振腔存在时,就创造了使这



种自发辐射转变为受激辐射的条件。当然这 种设想能否做成自由电子激光器还有待实验 证明。

3. 受激电磁冲击辐射

Schneider 和 Spitzer^[24]从1974年起连 续发表文章提出一种受激电磁冲击辐射机 理, 企图用来产生可调谐的强亚毫米波。 这 个机理将受激康普顿效应和切伦柯夫效应有 机地结合起来,即入射电子束与电磁波在媒 质中相互作用产生康普顿散射, 而电子速度 又满足切伦柯夫条件产生切伦柯夫辐射,由 于这二种效应有机地结合,产生的辐射并非 自发辐射而是受激辐射。受激辐射频率在入 射电磁波与电子束对头碰时可实现上频移, 平行碰时可实现下频移。如用微波与电子束 对头碰经上频移可得亚 毫米 波激光: 如用 CO2 激光与电子平行碰经下频移就可得16 微米激光。在下频移时电子束不必是相对论 的。这类媒质可以是气体,改变气体密度可 调节折射率,也可在慢波系统中进行。但也 未看到有关的实验结果。

六、讨 论

由上述分析可见,凡是自由电子产生自 发辐射的各种机理都可用来产生受激辐射, 因此大大开拓了研制激光器的领域。当然, 某种自发辐射能否转变成强的受激辐射,有 无实用价值,决定于受激辐射几率或增益,增 益饱和及振荡阈值等重要参量的大小。因此 计算这些参量并确定影响各种参量的基本因 素就是自由电子受激辐射理论研究的重要课 题之一。目前已有一些经典理论^[20]、半径典 理论^[27]和量子理论^[13,14],由于实验数据不 多,要定量比较这些理论是困难的。此外这 些理论还不能象普通激光器理论那样提供一 个清晰的物理图象,因此进一步发展这些理 论并用实验来验证这些理论是十分迫切的。 又因现有的理论都没有涉及自由电子在空间 不同点、不同时刻产生的受激辐射的相位问 题,即没有论证自由电子辐射的相干性问题, 而与普通激光器相比,这个问题显得更为重 要,也更难解决。

自由电子受激辐射最吸引人的特征就是 可实现电压调谐,即改变电子束的能量就可 改变相干辐射的频率,原则上可从毫米波段 经红外、可见及紫外波段直至 X 波段。此外 因为相对论电子束有极高的功率,即便转换 效率很低,也可产生高功率的相干辐射。因此 自由电子受激辐射为我们提供了一个波长连 续可调的高功率相干辐射源,这对于微波雷 达或激光雷达、可控热核聚变、激光分离同位 素、激光化学、激光光谱学等都是极其重要的。

从实验技术上说,自由电子受激辐射如 在毫米波段要用微波波导或谐振腔控制相干 辐射的模式;如在红外、可见或紫外波段则 要用光学谐振腔,当波长更短时能否通过超 辐射避免制造短波谐振腔的困难而实现*X*激 光?但这不是本质上的差别。它们的共同机 理都是自由电子受激辐射,把现在的产生微 波和激光的截然不同的传统方式通过强流相 对论电子束技术统一起来,不能不是电子学 的一个重大进展。

自由电子受激辐射理论有许多借助等离 子体理论来说明,使我们联想到等离子体(静 止的或相对论运动的)产生受激辐射的可能 性。现在已有气体、固体及液体激光器,可以 预言将来一定会出现用物质的第四态制成的 激光器即等离子体激光器。

我们还可看到,在毫米或亚毫米波段,电 子束与电磁波对碰的有泵浦波情形及电子束 经过横向周期静磁场的零频泵浦波情形都已 实验成功,但在光波段仅有后一种情形实验

. 8 .

成功,前一种情形还未见实验报导。估计是 因为波长变短时要求电子束电流密度和泵浦 波强度更高,入射与反射光波在同一轴线上 不易区分,光学谐振腔不易配置等困难造成 的。我们相信,随着强电子源与强光源的发 展以及理论的进一步深化,这方面的实验是 会成功的。

参考文献

- [1] H. Motz; J. Appl. Phys., 1951, 22, No. 5, 527; 1953, 24, No. 7, 826.
- [2] V. L. Granatstein et al., IEEE, Trans. Microwave Theory Tech. 1974, MTT-22, 1000.
- [3] D. A. G. Deacon; Phys. Rev. Lett., 1977, 38, No.
 6, 892.
- [4] K. Landecker; Phys. Rev., 1952, 86, No. 6, 852.
- [5] V. L. Granatstein et al.; Phys. Rev., 1976, A14, 1194~1201.
- [6] J. M. Buzzi et al.; IEEE, Trans. Microwave Theory Tech., 1977, MTT-25, No. 6, 559~560.
- [7] P. L. Kapitza, P. A. M. Dirac; Proc. Cambr. Phil. Soc., 1932, 29, 297~300.
- [8] H. Scharz; Phys. Lett., 1973, 43A, No. 5, 457~ 458.
- [9] Б. Р. Цикин и др.; Paduomex. и электрон., 1972, 17, №7, 1433~1438. V. А. Dubrovsku et al.; Sov. J. Quant. Electr., 1975, 5, No 10, 1248~1253; 1977, 7, No 7, 832~836.
- [10] R. H. Pantell; IEEE J. Quant. Electr., 1968, QE-4, No. 11, 905.
- [11] V. P. Sukhatme; J. Appl. Phys., 1973, 44 No. 5, 2331.

(上接第11页)

因为这两种介质对 5320 埃的激光有较小的 吸收系数,因此不能被有效地共振激发。但 肉眼仍能可见共轭反射波。

由以上的讨论,我们可以得出如下结论: 为了获得简并的四波混频反射波,可以选用 两种类型介质。一种是透明介质,其混频作 用是利用介质的非线性特性,因此,克尔非线 性大的介质,反射波也强。另一种介质是能 被共振激发的介质,这种四波混频作用是实 时全息照相过程。因此共振吸收越强,反射 波也越强。后一种过程是一种广义的四波混

- [12] V. P. Sukhatme et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1974, QE-10, No. 12, 870.
- [13] M. J. Madey; J. Appl. Phys., 1971, 42, No. 5, 906.
- [14] L. R. Elias; Phys. Rev. Lett., 1976, 36, No. 13, 717.
- [15] J. P. Blewett; J. Appl. Phys., 1977, 48, No. 7, 2692~2698.
- [16] V. L. Granatstem et al.; Appl. Lett., 1977, 30, No. 8, 384.
- T. C. Marshall et al.; Appl. Phys. Lett., 1977, 31, No. 5, 320~322.
- [18] V. L. Granatstem et al.; IEEE, Trans. Microwave Theory Tech., 1977, MTT-25, No. 6, 545.
- [19] D. Marcuse; Bell. System Technical. J.; 1962, 41, No. 5, 1557~1571.
- [20] F. Winterberg; JOSA, 1976, 66, No. 9, 966~968.
- [21] J. V. Jelly; Cevenkov Radiation and its Application, 1958.
- [22] J. E. Walsh et al.; The Physics of Fluids, 1977, 20, No. 4, 709~710.
- [23] A. Govtr, A. Yariv; Physics of Quantum Electronics, 1978.
- [24] S. Schneider, R. Spitzer; Nature, 1974, 250, No. 5468, 630~645. IEEE, Trans. Microwave Theory Tech., 1977, MTT-25, No. 6, 551~556.
- [25] H. Dekker; Physics Lett., 1976, 59A, No. 5, 369~370.
- [26] F. A. Hopf et al.; Opt. Commun., 1976, 13, 413. Phys. Rev. Lett., 1976, 37, No. 20, 1342~1345. Abawi et al.; Phys. Rev., 1977, A16, No. 2, 666 ~671. A. Hasegawa et al.; Appl. Phys. Lett., 1976, 29, No. 9, 542~544. T. Kwan et al.; Phys. Fluids, 1977, 20, No. 4, 581.
- [27] W. B. Colson; Phys. Lett., 1976, 59A, No. 3, 187.

频过程。用这种方法可以获得更强的反射 波。这就为利用四波混频作用进行信息处理 和信息储存开辟了更为广阔的前景。

参考文献

- [1] 吴存恺,杨天龙,舒海珍,王志英;《激光》,1979,6, No3,12。
- [2] A. Yariv: Opt. Commun., 1978, 25, 23.
- [3] R. M. Hellwarth; JOSA, 1977, 67, 1.
- [4] D. M. Eloom, G. C. Bjorlund: Appl. Phys. Lett., 1977, 31, 592.
- [5] S. M. Jensen, R. W. Hellwarth: Appl. Phys. Lett., 1977, 32, 3.